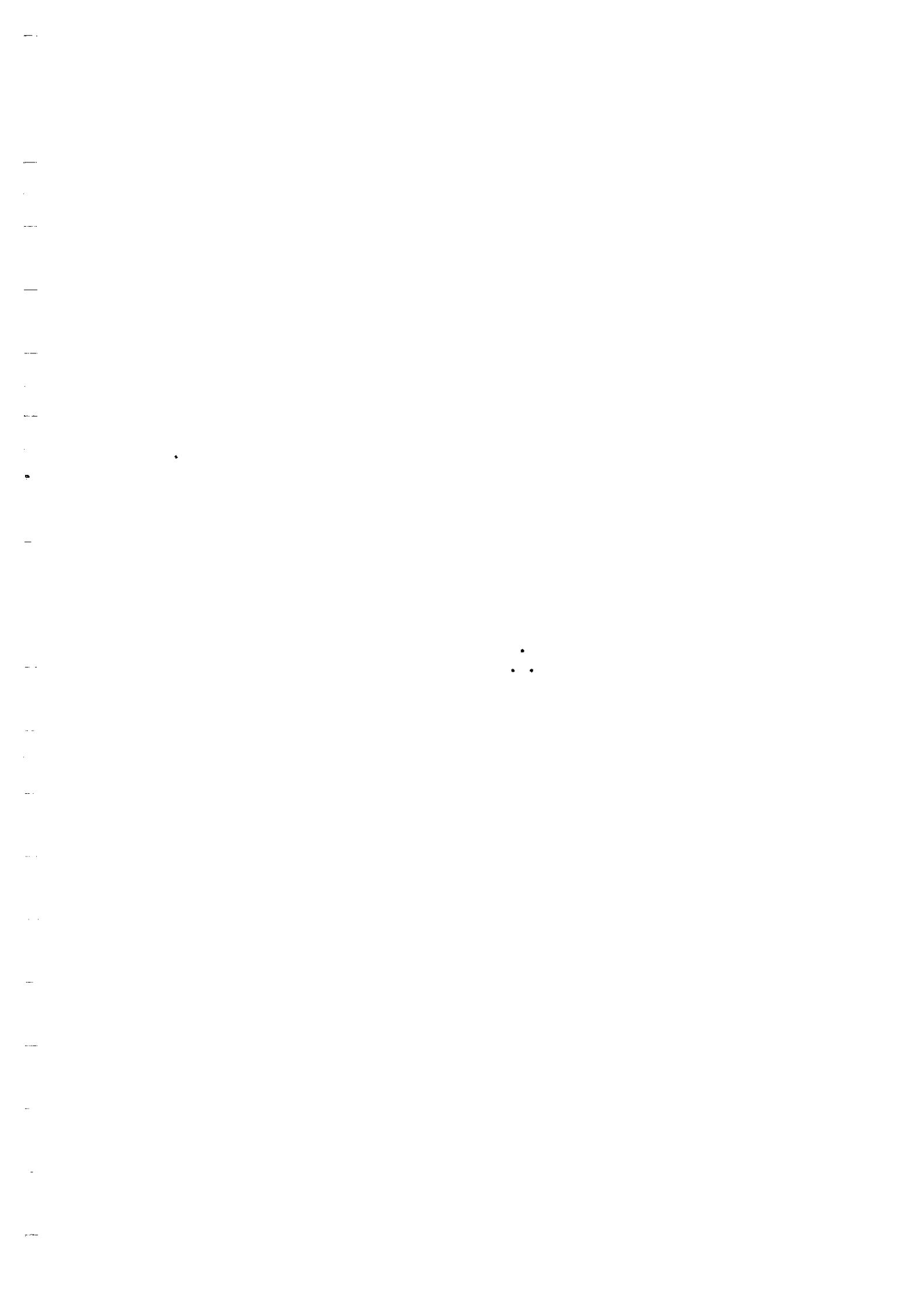


1. Publicação nº INPE-3171-PRE/541	2. Versão	3. Data Julho, 1984	5. Distribuição <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/> Restrita
4. Origem DTL/DAF	Programa SPAC/TRANSP		
6. Palavras chaves - selecionadas pelo(s) autor(es) <i>CHAVES</i> <i>DIODO PIN</i> <i>MICROONDAS</i>			
7. C.D.U.: 621.3.029.6			
8. Título	INPE-3171-PRE/541 <i>PROJETO DE CHAVES COM DIODO PIN</i>		
9. Autoria <i>Eduardo Antonio Parada Tude</i>	10. Páginas: 26 11. Última página: 19 12. Revisada por <i>luc</i> <i>Claudemir M. da Silva</i>		
<i>Eduardo Antonio Parada Tude</i> Assinatura responsável	13. Autorizada por <i>Tarade</i> <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor Geral</i>		
14. Resumo/Notas			
<p>Apresentam-se as técnicas de projeto de chaves com diodo PIN em microondas. Discute-se a ação do diodo PIN como elemento chaveador nos seus estados curto e aberto, bem como os vários tipos de chaves. Construíram-se duas chaves SPDT (uma entrada e duas saídas). A primeira, na frequência de 400 MHz, apresenta isolacão de 40 dB e perda de 0,75 dB; a segunda, em 2,2 GHz, tem 20 dB de isolacão e perda menor que 0,7 dB.</p>			
15. Observações Submetido para apresentação na 36ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciéncia - SBPC, de 4 a 11 de julho de 1984, em São Paulo, SP.			

ABSTRACT

This report describes the design of PIN switches in microwaves, the action of the PIN diode as a switch in the on and off states and several types of switches. Two SPDT (single pole double throw) switches prototypes were designed. The first, at 400 MHz, presents 40 dB isolation and 0.75 db insertion. The second, at 2.2 GHz, has 20 dB isolation and insertion low better than 0.7 dB.



SUMÁRIO

Pág.

LISTA DE FIGURAS	v
1. <u>INTRODUÇÃO</u>	1
2. <u>DIODO PIN</u>	1
2.1 - Física do diodo PIN	2
2.2 - Mudança de estado no diodo	4
2.3 - Circuito equivalente	5
3. <u>PROJETO DE CHAVES</u>	7
3.1 - Chave em 400 MHz	7
3.2 - Chave em 2,2 GHz	11
4. <u>CONCLUSÕES</u>	18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

LISTA DE FIGURAS

Pág.

1 - Diodo PIN	2
2 - Comportamento do diodo com a frequência	3
3 - Corrente no diodo	4
4 - Circuitos equivalentes do diodo PIN	5
5 - Resistência versus corrente de alimentação	6
6 - Circuito equivalente com encapsulamento para linha de fita ..	7
7 - Chave em 400 MHz	8
8 - Curva de transmissão para a chave de 400 MHz - Porta 1	9
9 - Curva de transmissão para a chave de 400 MHz - Porta 2	10
10 - Curva de transmissão para a chave de 2 GHz - Porta 1	16
11 - Curva de transmissão para a chave de 2 GHz - Porta 2	17

1. INTRODUÇÃO

Existem várias maneiras de construir uma chave em microondas. As mais comuns são as coaxiais e as que possuem diodo ou transistores como elemento chaveador. Dentre as chaves com diodo, a mais popular é a com diodo PIN, devido às suas características de chaveamento.

As chaves podem ser classificadas quanto ao número de portas como: SPST (uma entrada e uma saída), SPDT (uma entrada e duas saídas), ou "multithrow" (várias entradas e saídas).

Quanto à utilização do diodo como elemento chaveador, pode-se tê-lo em série, em paralelo, ou em uma combinação série e paralelo.

Neste trabalho, após algumas considerações sobre o diodo PIN na Seção 2, apresenta-se o projeto de duas chaves SPDT na Seção 3, sendo uma em 400 MHz e a outra em 2,2 GHz. Finalmente, na Seção 4 apresentam-se as conclusões.

2. DIODO PIN

O diodo PIN foi proposto inicialmente com um retificador de baixa frequência, que pode retificar mais potência que um simples diodo a junção PN, sem uma camada de alta resistividade. Entretanto, ele se torna um retificador pobre para frequência acima de poucos MHz. Suas características, no entanto, permitiram outros usos, principalmente em circuitos de chaveamento, pois com tensão de alimentação zero ou reversa o diodo apresenta alta impedância nas frequências de microondas, enquanto para uma corrente de alimentação moderada ele apresenta uma impedância muito baixa.

2.1 - FÍSICA DO DIODO PIN

O diodo PIN representado na Figura 1 é um diodo da junção PN, com uma camada intrínseca, "região I", entre a P e a N. A região I é aproximadamente uma camada π (P com alta resistividade) e uma ν (N com alta resistividade).

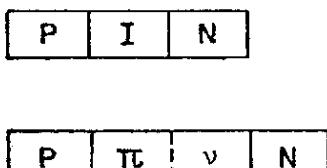


Fig. 1 - Diodo PIN.

Sem nenhuma tensão, uma camada de deplexão é formada na junção das camadas N e π . Com tensão reversa aplicada ao diodo (região P negativa), portadoras móveis vão da região π para a P, e a camada de deplexão aumenta até tomar toda a região π . Com uma corrente positiva aplicada ao diodo, buracos da região P e elétrons da N são injetados em π , o que aumenta a condutividade da região π , decrescendo a camada de deplexão.

Portanto, a condutância do diodo é proporcional à carga armazenada, que está relacionada à corrente no diodo, ou seja:

$$i_d = \frac{dQ_d}{dt} + \frac{Q_d}{\tau}, \quad (1)$$

onde i_d e Q_d são a corrente e a carga no diodo, e τ é o tempo de vida de recombinação.

Se $i_d = \text{cte}$, ter-se-á $Q_d = i_d \tau$.

Se $i_d = \text{cte} + i(\omega)$, a componente contínua será modulada pela presença da componente de corrente alternada. O grau de modulação depende do nível dos sinais e da frequência do sinal de RF, uma vez que:

$$Q_d(\omega) = \frac{i_d \tau(j\omega)}{1 + j\omega\tau} \quad (2)$$

Esta expressão foi obtida a partir da transformada de Laplace da Equação 1, representada na Figura 2.

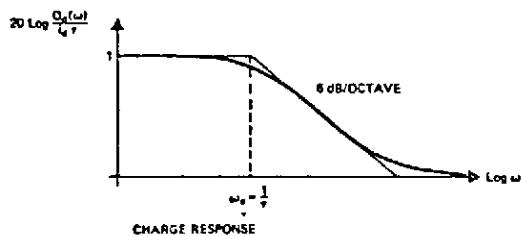


Fig. 2 - Comportamento do diodo com a frequência.

FONTE: Hewlett Packard (s.d.), p.1.

Para frequências menores que $f_0 = 1/2\pi\tau$, o sinal de RF exerce o mesmo efeito que o sinal contínuo, mas este efeito decresce para frequências mais altas, ou seja, para $f < f_0$ o diodo funciona como um diodo a junção PN, conforme a idéia inicial do projeto do diodo. Na vizinhança de f_0 , o diodo começa a se comportar como um resistor linear, com um componente não-linear pequeno. O sinal consequentemente sofre algum grau de distorção. Para frequências $f >> f_0$, o diodo aparece como uma resistência puramente linear, cujo valor pode ser controlado por um sinal contínuo ou de baixa frequência. Na ação de chaveamento considerar-seão, portanto, sinais de RF em que $f >> f_0$.

2.2 - MUDANÇA DE ESTADO NO DIODO

O diodo PIN, atuando como chave, varia entre dois estados:

- 1) possui alta resistência e corresponde a uma tensão V negativa ou V_{aberto} ;
- 2) possui resistência baixa para uma corrente de alimentação I ou I_{curto} .

Analisa-se agora a transição entre estes dois estados.

A partir das condições iniciais tem-se o diodo com um equilíbrio de cargas na camada intrínseca. Uma corrente aplicada (I_C) ao diodo fará surgir uma carga armazenada Q_d . Ao aplicar uma tensão reversa, a carga armazenada no diodo produzirá uma corrente reversa (I_r) que durará até que esta carga seja totalmente removida, ou $I_r\tau = Q_d$.

Esta corrente varia com o projeto do diodo, tem basicamente a forma apresentada na Figura 3 e é composta por um platô constante e por uma região variável.

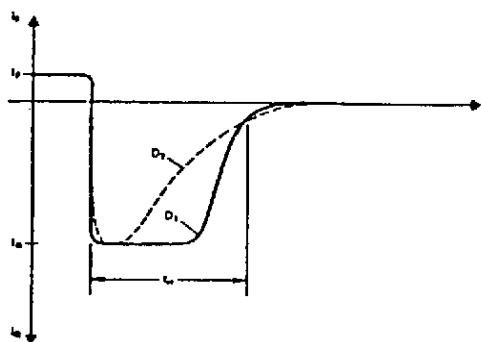


Fig. 3 - Corrente no diodo.

A velocidade de chaveamento pode ser aumentada pela diminuição do platô constante, por meio de um ajuste de I_C e I_r . JÁ a parte variável não pode ser reduzida, dependendo da estrutura do diodo. Pode-se dizer que: "O mínimo tempo de mudança realizável entre os dois estados de impedância é a parte do tempo de transição com I_r variável."

Portanto, a tensão reversa serve para apressar a transição (Q maior) e para remover pequenas quantidades de carga devido ao sinal de RF de alta potência. A extração destas cargas é chamada pulso de perda de corrente.

2.3 - CIRCUITO EQUIVALENTE

O diodo PIN pode ser representado pelos circuitos equivalentes apresentados na Figura 4.

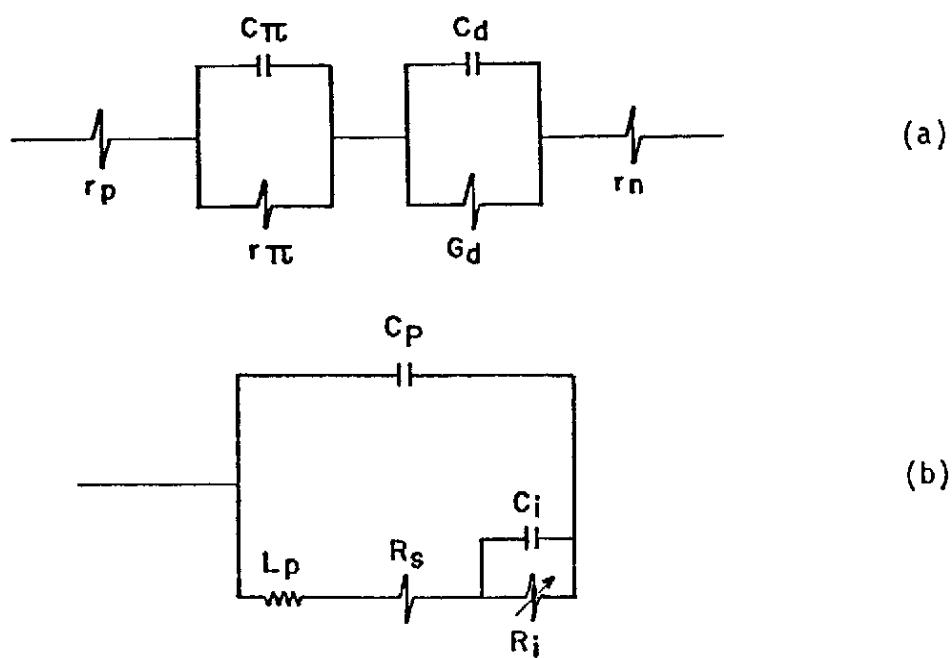


Fig. 4 - Circuitos equivalentes do diodo PIN.

Na Figura 4a, há uma correspondência entre os elementos do circuito e as camadas apresentadas na Figura 1, com r_p e r_n representando as camadas P e N; e C_π , r_π e C_d representando as camadas π e de deplexão da região I.

Na Figura 4b, apresenta-se um circuito equivalente mais compacto, onde R_s representa a resistência série produzida pelas camadas P e N; e C_i e R_i representam a região intrínseca I.

Para $f \ll f_0$, C_i é fixa e R_i é dada por:

$$R_i = \frac{K}{I_{CC}^x}, \quad (3)$$

onde K e x são determinados experimentalmente, e I_{CC} é a corrente contínua no diodo.

Na Figura 5 tem-se uma curva típica para a variação de R_i com I_{CC} .

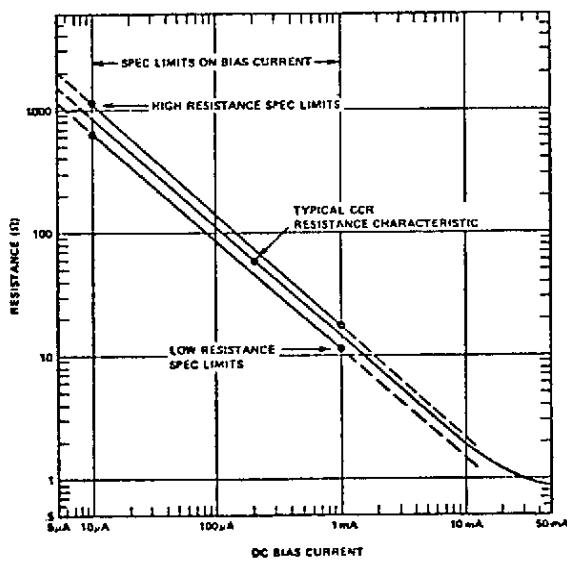


Fig. 5 - Resistência versus corrente de alimentação.

FONTE: Hewlett Packard (s.d.), p.2.

L_p e C_p representam o tipo de encapsulamento do diodo. Para frequências maiores que 500 MHz, costuma-se sintonizar estes elementos parasitas através de reatâncias adicionais externas, de modo a garantir a performance do circuito em uma banda maior.

Para montagens em linha de fita, encontram-se diodos cujos elementos internos são projetados para formar um filtro passa-baixa, com alta frequência de corte (30 GHz). Na Figura 6 apresenta-se um circuito equivalente para este tipo de diodo.

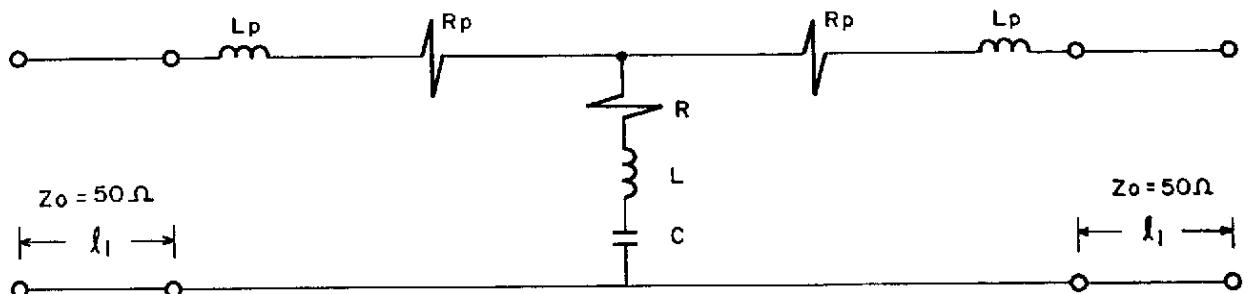


Fig. 6 - Circuito equivalente com encapsulamento para linha de fita.

3. PROJETO DE CHAVES

3.1 - CHAVE EM 400 MHz

Para construir uma chave em 400 MHz selecionou-se o diodo HP 5082-3043, que pode ter seu circuito equivalente representado por um resistor ($R_S = 1,5\Omega$) para o estado em curto e por um capacitor ($C_T = 0,4\text{ pF}$) para o estado em aberto. A chave é do tipo SPDT e com os diodos na configuração série paralela, para obter maior isolamento, conforme a Figura 7.

A chave apresentou perda menor que 0,75 dB (Figuras 8 e 9) e isolamento maior que 40 dB.

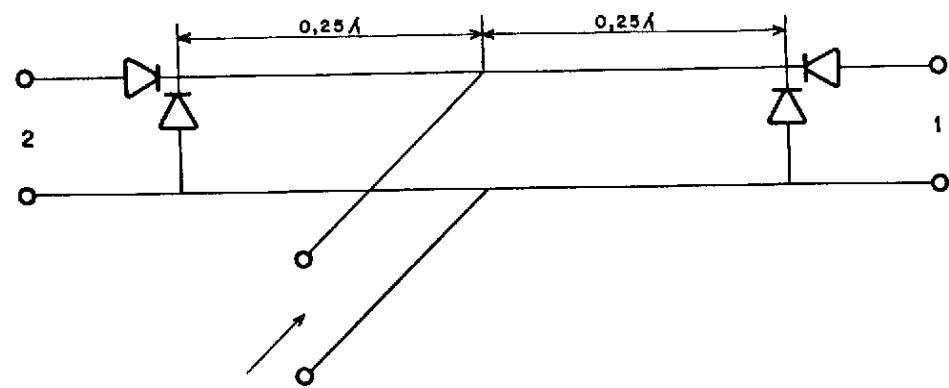


Fig. 7 - Chave em 400 MHz.

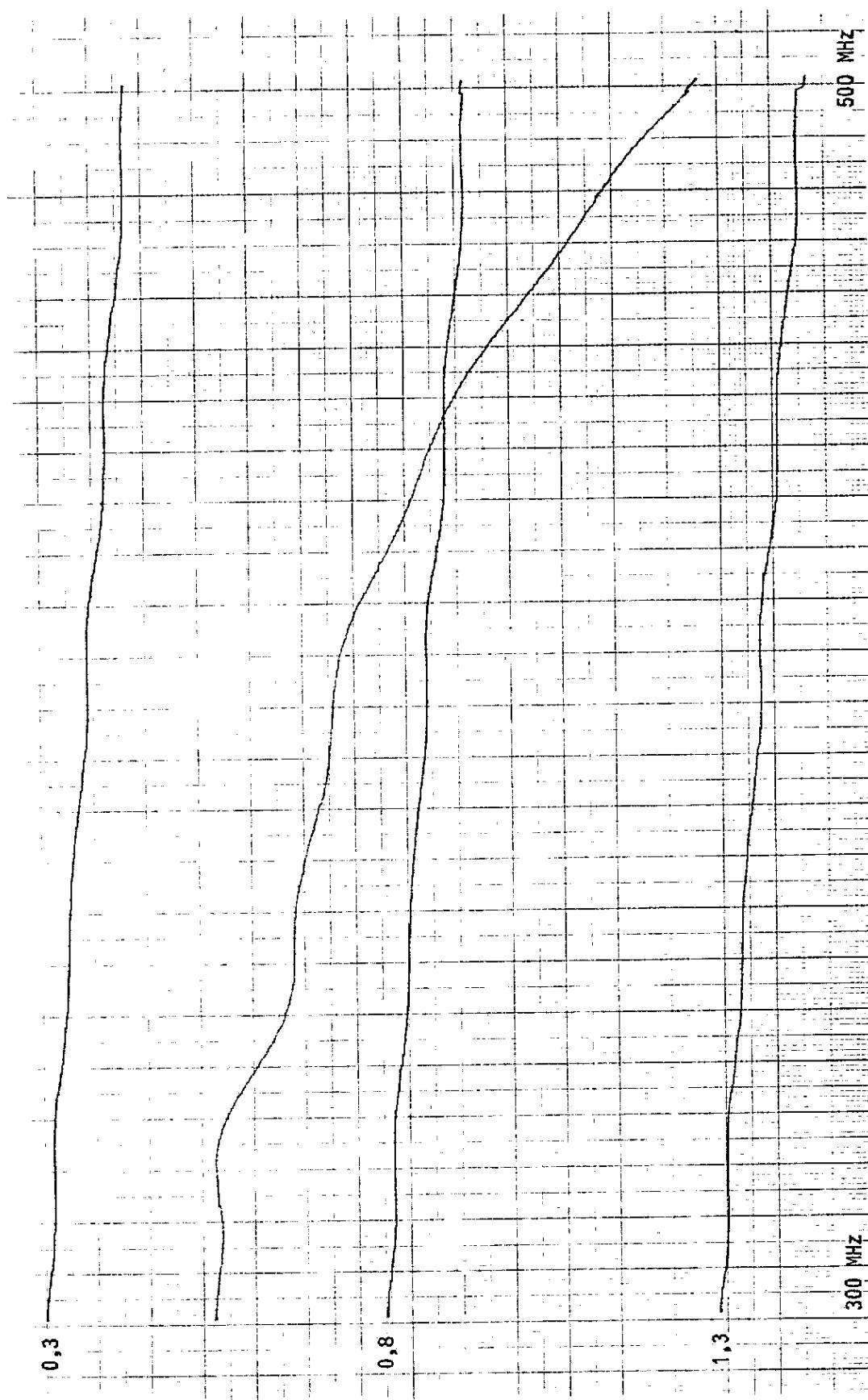


Fig. 8 - Curva de transmissão para a chave de 400 MHz - Porta 1.

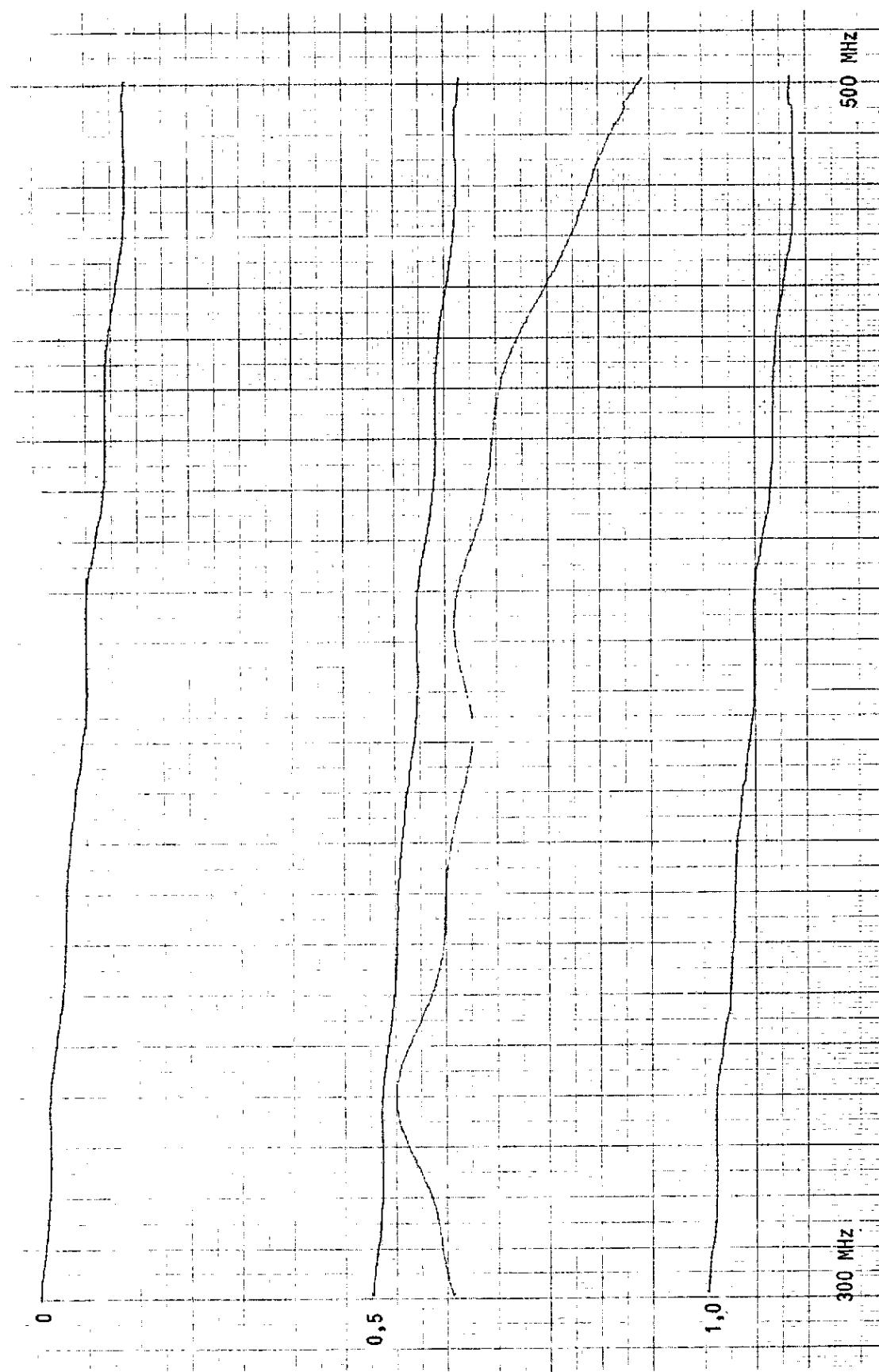


Fig. 9 - Curva de transmissão para a chave de 400 MHz - Porta 2.

3.2 - CHAVE EM 2,2 GHz

Esta chave utilizou diodos PIN HP 5082 3040, que têm encapsulamento especial para "microstrip". O circuito equivalente considerado está representado na Figura 6 com os valores dos elementos da Tabela 1.

TABELA 1

PARÂMETROS DO DIODO

	ISOLACÃO	TRANSMISSÃO
R _p	0,25Ω	0,25Ω
L _p	200 pH	200 pH
e ₁	2,4 mm	2,4 mm
e ₂	5,0 mm	5,0 mm
L	20 pHΩ	0
C	∞	0,1 pF

Este diodo teve sua performance analisada pelo programa PROCAOC, conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3, para os estados de isolacão e transmissão. O circuito montado é semelhante ao da Figura 7 e tem uma análise apresentada nas Tabelas 4 e 5. A chave apresentou perda menor que 0,7 dB (Figuras 10 e 11) e isolacão maior que 20 dB.

TABELA 2
DIODO NO ESTADO DE ISOLACAO

FREQUENCIA (HZ)	SINAL DE ENTRADA	SINAL DE SAIDA	GANHO DIRETO (dB)	GANHO REVERSO (dB)	DEFASAGEM (GRAUS)	ATRASO DE GRUPO (SEGUNDOS)
1.500E+00	40.69	40.690	-28.247	-26.247	-7.3	-1.395E-11
1.600E+00	40.697	40.697	-28.229	-28.229	-7.8	-1.404E-11
1.700E+00	40.705	40.705	-28.199	-28.209	-8.3	-1.414E-11
1.800E+00	40.714	40.714	-28.168	-28.186	-8.8	-1.424E-11
1.900E+00	40.723	40.723	-28.137	-28.167	-9.3	-1.435E-11
2.000E+00	40.733	40.733	-28.144	-28.144	-9.6	-1.446E-11
2.100E+00	40.743	40.743	-28.120	-28.120	-10.3	-1.458E-11
2.200E+00	40.753	40.753	-28.095	-28.095	-10.9	-1.470E-11
2.300E+00	40.754	40.754	-28.094	-28.094	-10.9	-1.470E-11
2.400E+00	40.754	40.754	-28.093	-28.093	-10.9	-1.471E-11
2.500E+00	40.755	40.755	-28.091	-28.091	-10.9	-1.471E-11
2.600E+00	40.756	40.756	-28.090	-28.090	-11.0	-1.472E-11
2.700E+00	40.756	40.756	-28.089	-28.089	-11.0	-1.473E-11
2.800E+00	40.756	40.756	-28.088	-28.088	-11.0	-1.473E-11
2.900E+00	40.757	40.757	-28.086	-28.086	-11.0	-1.474E-11
2.230E+00	40.757	40.757	-28.085	-28.085	-11.1	-1.475E-11
2.240E+00	40.758	40.758	-28.084	-28.084	-11.1	-1.475E-11
2.250E+00	40.758	40.758	-28.082	-28.082	-11.1	-1.476E-11
2.260E+00	40.759	40.759	-28.081	-28.081	-11.2	-1.476E-11
2.270E+00	40.760	40.760	-28.080	-28.080	-11.2	-1.477E-11
2.280E+00	40.761	40.761	-28.079	-28.079	-11.2	-1.478E-11
2.290E+00	40.761	40.761	-28.077	-28.077	-11.2	-1.478E-11
2.300E+00	40.761	40.761	-28.076	-28.076	-11.3	-1.479E-11
2.270E+00	40.762	40.762	-28.075	-28.075	-11.3	-1.479E-11
2.280E+00	40.762	40.762	-28.073	-28.073	-11.3	-1.480E-11
2.290E+00	40.763	40.763	-28.072	-28.072	-11.3	-1.481E-11
2.300E+00	40.763	40.763	-28.071	-28.071	-11.4	-1.481E-11
2.295E+00	40.764	40.764	-28.069	-28.069	-11.4	-1.482E-11
2.300E+00	40.764	40.764	-28.069	-28.069	-11.4	-1.482E-11
2.300E+00	40.764	40.764	-28.069	-28.069	-11.4	-1.482E-11
2.400E+00	40.770	40.770	-28.033	-28.043	-11.9	-1.495E-11
2.500E+00	40.780	40.780	-28.015	-28.015	-12.5	-1.508E-11
2.600E+00	40.801	40.801	-27.937	-27.937	-13.0	-1.521E-11
2.700E+00	40.814	40.814	-27.957	-27.957	-13.0	-1.535E-11
2.800E+00	40.827	40.827	-27.927	-27.927	-14.1	-1.549E-11
2.900E+00	40.841	40.841	-27.896	-27.896	-14.7	-1.563E-11
3.000E+00	40.855	40.855	-27.854	-27.854	-15.2	-1.578E-11
3.100E+00	40.871	40.871	-27.811	-27.811	-15.2	-1.593E-11
3.200E+00	40.880	40.880	-27.798	-27.798	-16.4	-1.608E-11
3.300E+00	40.902	40.902	-27.764	-27.764	-16.9	-1.623E-11
3.400E+00	40.914	40.914	-27.729	-27.729	-17.5	-1.638E-11
3.500E+00	40.936	40.936	-27.694	-27.694	-18.1	-1.654E-11

TABELA 3

DIODO NO ESTADO DE TRANSMISSÃO

FREQUÊNCIA (HZ)	SINAL DE ENTRADA	SINAL DE SAÍDA	GANHO DIRETO (DB)	ATRASO DE RETRASO (SEJUNDOS)	DEFASAGEM (GRAUS)	ATRASO DE GRUPO (SEJUNDOS)
1.500E+00	1.079	1.079	-0.092	-16.3		
1.600E+00	1.085	1.093	-0.093	-17.4		
1.700E+00	1.091	-0.094	-0.094	-18.5		
1.800E+00	1.097	-0.095	-0.095	-19.6		
1.900E+00	1.103	-0.096	-0.096	-20.6		
2.000E+00	1.108	-0.098	-0.098	-21.7		
2.100E+00	1.114	-0.099	-0.099	-22.6		
2.200E+00	1.120	-0.100	-0.100	-23.9		
2.205E+00	1.121	-0.100	-0.100	-23.9		
2.210E+00	1.121	-0.100	-0.100	-24.0		
2.215E+00	1.121	-0.100	-0.100	-24.0		
2.220E+00	1.121	-0.100	-0.100	-24.1		
2.225E+00	1.122	-0.101	-0.101	-24.1		
2.230E+00	1.122	-0.101	-0.101	-24.2		
2.235E+00	1.122	-0.101	-0.101	-24.3		
2.240E+00	1.123	-0.101	-0.101	-24.4		
2.245E+00	1.123	-0.101	-0.101	-24.4		
2.250E+00	1.123	-0.101	-0.101	-24.5		
2.255E+00	1.124	-0.101	-0.101	-24.5		
2.260E+00	1.124	-0.101	-0.101	-24.6		
2.265E+00	1.124	-0.101	-0.101	-24.6		
2.270E+00	1.124	-0.101	-0.101	-24.7		
2.275E+00	1.125	-0.101	-0.101	-24.7		
2.280E+00	1.125	-0.101	-0.101	-24.8		
2.285E+00	1.125	-0.101	-0.101	-24.8		
2.290E+00	1.126	-0.102	-0.102	-24.9		
2.295E+00	1.126	-0.102	-0.102	-24.9		
2.300E+00	1.126	-0.102	-0.102	-25.0		
2.305E+00	1.126	-0.102	-0.102	-25.0		
2.400E+00	1.134	-0.103	-0.103	-26.0		
2.500E+00	1.134	-0.105	-0.105	-27.1		
2.600E+00	1.144	-0.106	-0.106	-26.2		
2.700E+00	1.154	-0.108	-0.108	-24.3		
2.800E+00	1.156	-0.109	-0.109	-30.4		
2.900E+00	1.162	-0.111	-0.111	-31.4		
3.000E+00	1.168	-0.113	-0.113	-32.5		
3.100E+00	1.175	-0.115	-0.115	-33.6		
3.200E+00	1.181	-0.117	-0.117	-34.7		
3.300E+00	1.187	-0.119	-0.119	-35.8		
3.400E+00	1.193	-0.121	-0.121	-36.9		
3.500E+00	1.194	-0.123	-0.123	-37.9		

TABELA 4
CIRCUITO NO ESTADO DE TRANSMISSÃO

FREQUÊCIA (HZ)	SINAL DE ENTRADA	JNR DE SAÍDA	GANHO DIRETO (DB)	SINAL REVERSO (DB)	DEFASAGEM (GRAUS)	ATRASO DE GRUPO (SEGUNDOS)
1.500 + 00	1.387	1.390	-0.327	-0.327	-130.2	0.
1.600 + 00	1.125	1.260	-0.260	-0.260	-142.2	0.
1.700 + 00	1.135	1.149	-0.217	-0.217	-154.0	0.
1.800 + 00	1.033	1.064	-0.197	-0.197	-165.8	0.
1.900 + 00	1.061	1.075	-0.197	-0.197	-177.6	0.
2.000 + 00	1.150	1.156	-0.215	-0.215	-170.8	0.
2.100 + 00	1.261	1.255	-0.250	-0.250	-159.1	0.
2.200 + 00	1.364	1.356	-0.299	-0.299	-147.5	0.
2.210 + 00	1.374	1.362	-0.302	-0.302	-146.9	0.
2.215 + 00	1.386	1.367	-0.305	-0.305	-146.3	0.
2.220 + 00	1.391	1.372	-0.308	-0.308	-145.7	0.
2.225 + 00	1.397	1.376	-0.311	-0.311	-145.2	0.
2.230 + 00	1.405	1.383	-0.314	-0.314	-144.6	0.
2.235 + 00	1.407	1.388	-0.317	-0.317	-144.0	0.
2.240 + 00	1.414	1.394	-0.320	-0.320	-143.4	0.
2.245 + 00	1.419	1.399	-0.323	-0.323	-142.8	0.
2.250 + 00	1.425	1.404	-0.326	-0.326	-142.3	0.
2.255 + 00	1.431	1.411	-0.329	-0.329	-141.7	0.
2.260 + 00	1.431	1.415	-0.332	-0.332	-141.1	0.
2.265 + 00	1.436	1.421	-0.335	-0.335	-140.5	0.
2.270 + 00	1.442	1.427	-0.339	-0.339	-139.9	0.
2.275 + 00	1.445	1.431	-0.342	-0.342	-139.3	0.
2.280 + 00	1.445	1.437	-0.345	-0.345	-138.8	0.
2.285 + 00	1.446	1.444	-0.348	-0.348	-136.2	0.
2.290 + 00	1.447	1.453	-0.352	-0.352	-137.6	0.
2.295 + 00	1.447	1.454	-0.355	-0.355	-137.0	0.
2.300 + 00	1.448	1.461	-0.359	-0.359	-136.4	0.
2.300 + 00	1.448	1.461	-0.362	-0.362	-135.9	0.
2.300 + 00	1.463	1.463	-0.362	-0.362	-135.9	0.
2.300 + 00	1.603	1.579	-0.436	-0.436	-124.2	0.
2.300 + 00	1.733	1.706	-0.526	-0.526	-112.5	0.
2.600 + 00	1.874	1.832	-0.634	-0.634	-106.6	0.
2.000 + 00	2.032	1.981	-0.758	-0.758	-86.6	0.
2.800 + 00	2.212	2.149	-0.949	-0.909	-76.3	0.
2.900 + 00	2.433	2.354	-1.096	-1.096	-63.6	0.
3.000 + 00	2.722	2.613	-1.337	-1.337	-50.6	0.
3.100 + 00	3.103	2.955	-1.658	-1.658	-37.3	0.
3.200 + 00	3.647	3.447	-2.103	-2.103	-23.2	0.
3.300 + 00	4.464	4.174	-2.735	-2.735	-6.4	0.
3.400 + 00	5.767	5.319	-3.657	-3.657	-7.3	0.
3.500 + 00	6.067	7.225	-5.026	-5.026	-23.7	0.

TABELA 5

CIRCUITO NO ESTADO DE ISOLACAO

FREQUENCIA (HZ)	SINAL DE ENTRADA	SINAL DE SAIDA	GAINO DIRETO (DB)	GAINO REVERSO (DB)	DEFASAGEM (GRAUS)	ATRASO DE GRUPO (SEGUNDOS)
1.500±0.0	1.387	40.508	-33.416	-53.476	-143.2	0*
1.600±0.0	1.252	40.493	-33.644	-33.644	-150.4	0*
1.700±0.0	1.135	40.479	-33.785	-33.785	-157.6	0*
1.800±0.0	1.033	40.467	-33.899	-33.899	-164.6	0*
1.900±0.0	1.061	40.457	-33.985	-33.985	-171.5	0*
2.000±0.0	1.151	40.447	-34.040	-34.040	-176.4	0*
2.000±0.0	1.261	40.436	-34.062	-34.062	-174.9	0*
2.200±0.0	1.364	40.430	-34.046	-34.046	168.3	0*
2.205±0.0	1.374	40.431	-34.044	-34.044	168.0	0*
2.210±0.0	1.381	40.430	-34.042	-34.042	167.6	0*
2.215±0.0	1.382	40.429	-34.040	-34.040	167.3	0*
2.220±0.0	1.391	40.429	-34.038	-34.038	167.0	0*
2.225±0.0	1.397	40.429	-34.036	-34.036	166.6	0*
2.230±0.0	1.401	40.428	-34.033	-34.033	166.3	0*
2.235±0.0	1.402	40.428	-34.031	-34.031	166.0	0*
2.240±0.0	1.414	40.427	-34.028	-34.028	165.7	0*
2.245±0.0	1.417	40.427	-34.025	-34.025	165.3	0*
2.250±0.0	1.422	40.427	-34.023	-34.023	165.0	0*
2.255±0.0	1.431	40.426	-34.020	-34.020	164.7	0*
2.260±0.0	1.436	40.426	-34.017	-34.017	164.3	0*
2.265±0.0	1.444	40.426	-34.013	-34.013	164.0	0*
2.270±0.0	1.446	40.425	-34.010	-34.010	163.7	0*
2.275±0.0	1.454	40.425	-34.007	-34.007	163.4	0*
2.280±0.0	1.459	40.425	-34.003	-34.003	163.0	0*
2.285±0.0	1.465	40.424	-34.000	-34.000	162.7	0*
2.290±0.0	1.471	40.424	-33.996	-33.996	162.4	0*
2.295±0.0	1.477	40.424	-33.992	-33.992	162.1	0*
2.300±0.0	1.483	40.423	-33.988	-33.988	161.7	0*
2.300±0.0	1.483	40.423	-33.988	-33.988	161.7	0*
2.400±0.0	1.603	40.417	-33.862	-33.862	155.2	0*
2.500±0.0	1.733	40.413	-33.723	-33.723	146.6	0*
2.600±0.0	1.814	40.414	-33.504	-33.504	142.3	0*
2.700±0.0	2.032	40.411	-33.220	-33.220	135.7	0*
2.800±0.0	2.121	40.415	-32.855	-32.855	129.0	0*
2.900±0.0	2.431	40.420	-32.446	-32.446	122.0	0*
3.000±0.0	2.722	40.446	-31.932	-31.932	114.6	0*
3.100±0.0	3.033	40.480	-31.357	-31.357	106.8	0*
3.200±0.0	3.647	40.535	-30.723	-30.723	98.2	0*
3.300±0.0	4.161	40.617	-30.050	-30.050	88.6	0*
3.400±0.0	5.789	40.735	-29.374	-29.374	78.3	0*
3.500±0.0	8.067	40.893	-28.744	-28.744	66.8	0*

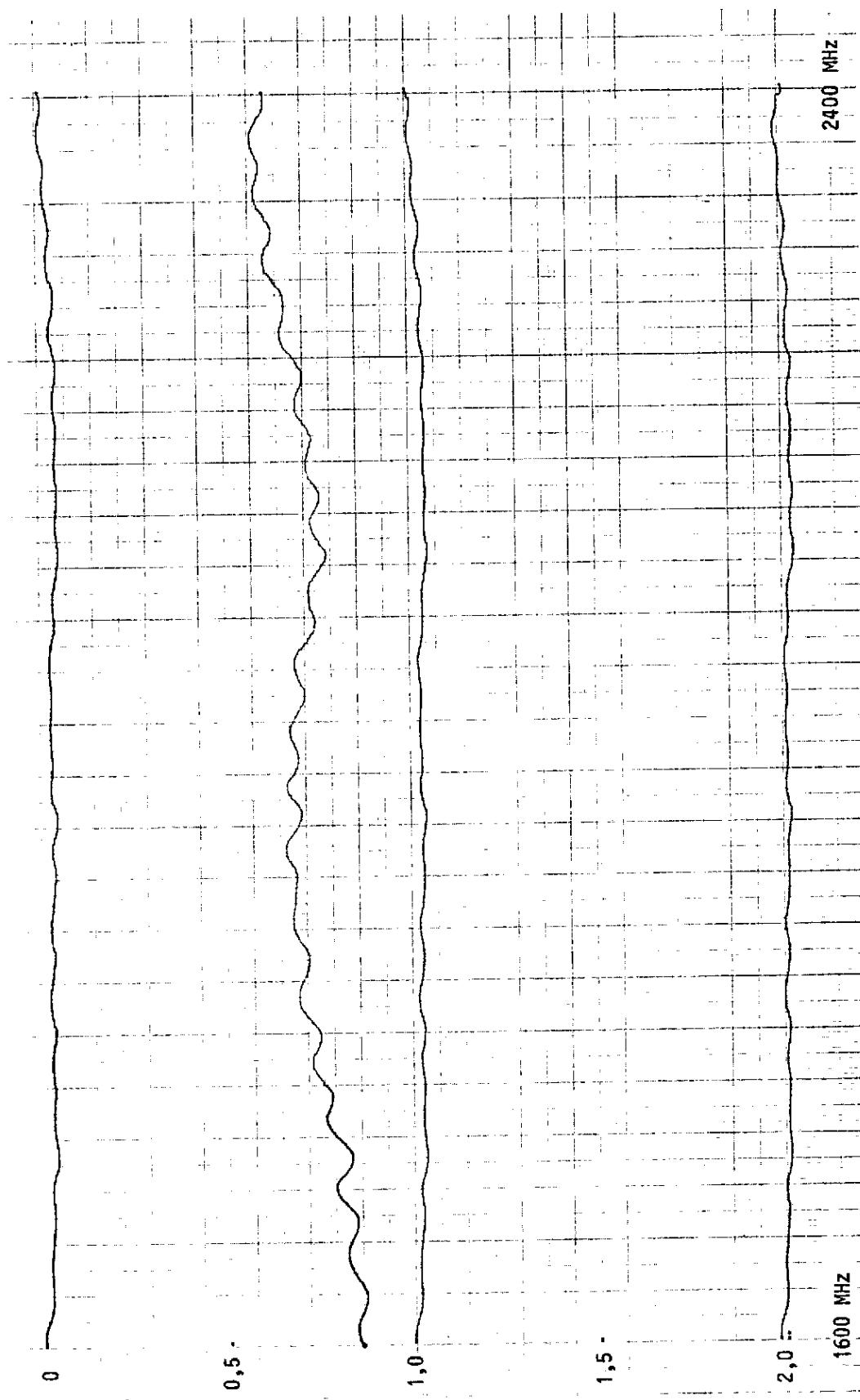


Fig. 10 - Curva de transmissão para a chave de 2 GHz - Porta 1.

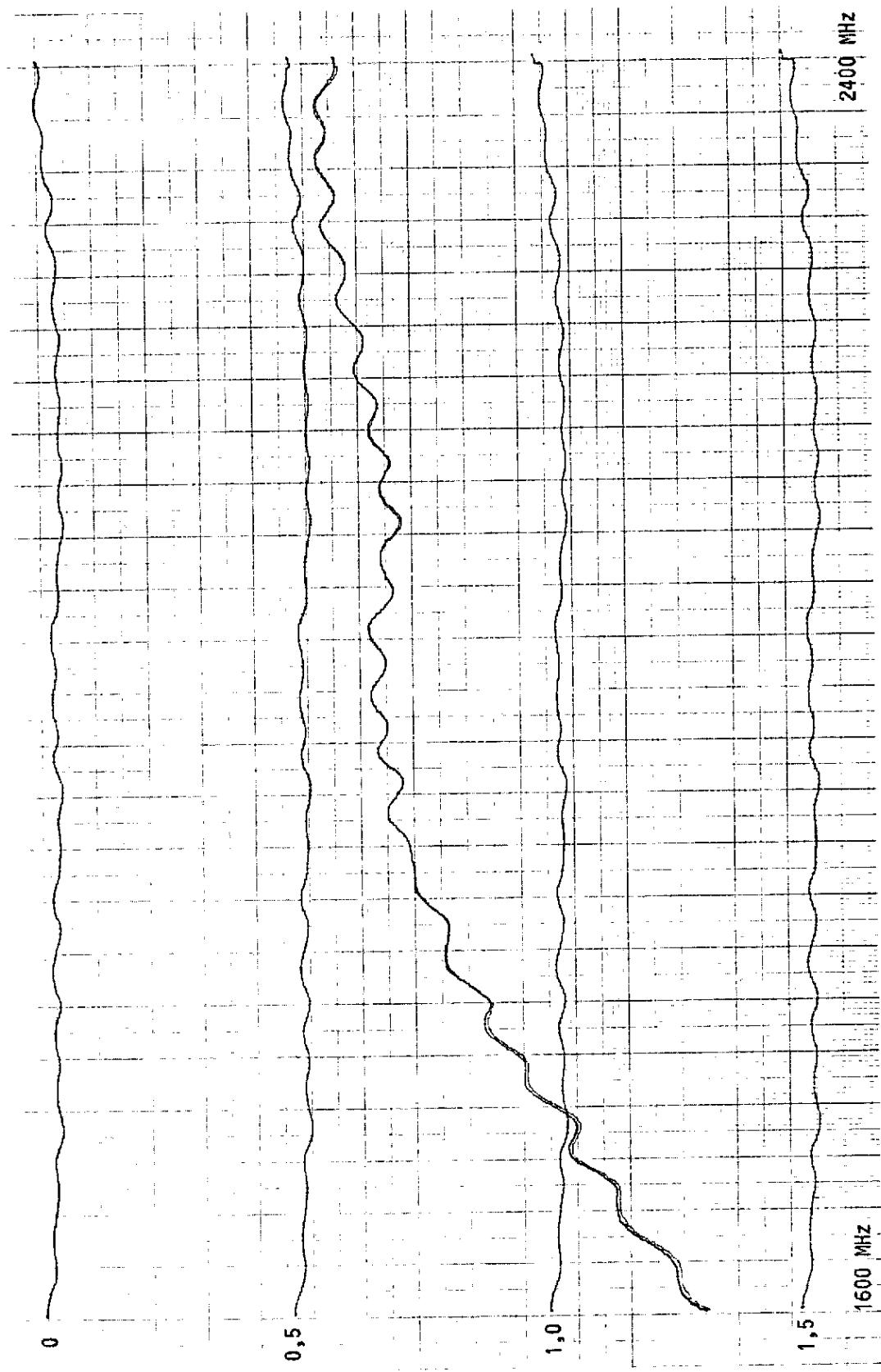


Fig. 11 - Curva de transmissão para a chave de 2 GHz - Porta 2.

4. CONCLUSÕES

Apresentou-se o projeto de duas chaves SPDT em microondas, analisaram-se suas características e mediram-se seus resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HEWLETT PACKARD. *Applications of PIN Diodes.* Palo Alto, CA, s.d.
(Application Note 922).